

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 533.9+535.34

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ЛИНЕЙЧАТОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
ПРИ БОЛЬШИХ ОПТИЧЕСКИХ ПЛОТНОСТЯХ

В. В. Скidan и Е. Я. Шрейдер

Применение метода поглощения [1, 2] для определения больших оптических плотностей сопряжено со значительными трудностями, так как поглощение очень медленно растет с увеличением оптической плотности.

Для описания контуров спектральных линий испускания и поглощения введем следующие обозначения: $k_0 l$ и $k'_0 l'$ — соответственно оптические плотности в поглощающем и излучающем слоях, a и a' — соответственно параметры Фойгта для линии поглощения и испускания.

В некотором диапазоне оптических плотностей (диапазон зависит от величины a) кривая поглощения идет более круто, если меняется оптическая плотность излучающего, а не поглощающего слоя. Поэтому мы предлагаем использовать исследуемую плазму в качестве излучающего слоя.

В таблице приведены результаты вычисления изменения величины поглощения ΔA при десятикратном увеличении оптической плотности поглощающего и излучающего слоев. Чем больше ΔA , тем круче идет кривая поглощения. Расчет велся по формуле

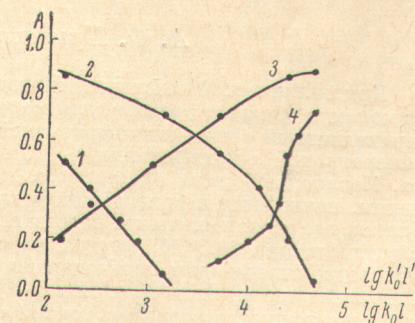
$$A = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \left(1 - e^{-k'_0 l' \left\{ e^{-\omega^2} - \frac{2a'}{\sqrt{\pi}} [1 - 2\omega F(\omega)] \right\}} \right) \left(1 - e^{-k_0 l \left\{ e^{-\omega^2} - \frac{2a}{\sqrt{\pi}} [1 - 2\omega F(\omega)] \right\}} \right) d\omega}{\int_{-\infty}^{+\infty} \left(1 - e^{-k'_0 l' \left\{ e^{-\omega^2} - \frac{2a}{\sqrt{\pi}} [1 - 2\omega F(\omega)] \right\}} \right) d\omega},$$

где $\omega = 2\sqrt{\ln 2} (\nu - \nu_0)/\Delta\nu_D$; $\nu - \nu_0$ — расстояние от центра линии по шкале частот, $\Delta\nu_D$ — допплеровская ширина линии, $F(\omega)$ — функция, характеризующая линию поглощения при $a \leq 0.01$ [3].

Как видно из таблицы, чем больше a , тем при меньших оптических плотностях проявляются преимущества предлагаемого метода, т. е. уменьшение поглощения за счет уширения линии испускания с ростом оптической плотности происходит более быстро, чем рост поглощения в связи с увеличением числа поглощающих атомов.

Возможность использования зависимости поглощения от оптической плотности излучающего слоя при построении кривых поглощения проверялась на примере определения концентрации атомов водорода, создаваемых в разряде. Измерялось поглощение линии L_α (1216 Å). Параметр Фойгта менялся в зависимости от давления от 0.0025 до 0.0052. Установка описана в статьях авторов [4]. Предполагается, что в условиях эксперимента достигается полная диссоциация молекул водорода.

Измеренные поглощения оказались ниже расчетных, что, по-видимому, связано с неоднородностью излучающего слоя вблизи окна эмиссионной разрядной трубки. Как видно из рисунка, в области оптических плотностей от 100 до 1000 наклон кривой 3 больше наклона кривой 2, что подтверждает целесообразность использования излучающего слоя для определения концентрации нормальных атомов.



Зависимость величины поглощения A от оптической плотности.

Кривые 1 и 2 — зависимость A от $k'_0 l'$ для $k_0 l = 1100$ и $k_0 l = 23000$ соответственно.

Кривые 3 и 4 — зависимость A от $k_0 l$ для $k'_0 l' = 140$ и $k'_0 l' = 5000$ соответственно.

Диапазон оптических плотностей	$a = a' = 0.0025$		$a = a' = 0.01$	
	обычный метод * ΔA	предлагаемый метод ** ΔA	обычный метод * ΔA	предлагаемый метод ** ΔA
$10^1 \div 10^2$	0.207	0.169	0.201	0.209
$10^2 \div 10^3$	0.130	0.218	0.166	0.347
$10^3 \div 10^4$	0.189	0.394	0.287	0.369

* $k'_0 l'$ выбирается равным верхней границе интервала оптических плотностей.

** $k_0 l$ выбирается равным нижней границе интервала оптических плотностей.

Предлагаемый метод позволяет проводить регистрацию сигнала при прохождении излучения через слой несветящихся атомов, а в общепринятом варианте метода поглощения регистрация сигнала происходит на фоне шумов, создаваемых излучением просвечиваемой плазмы.

Описанный метод может найти применение и в тех случаях, когда обычный метод поглощения не применим, например, при исследовании далеких объектов.

В заключение мы благодарим А. Н. Зайделя за обсуждение результатов работы.

Литература

- [1] А. Митчелл, М. Земанский. Резонансное излучение и возбужденные атомы, ОНТИ, 1937.
- [2] С. Э. Фриш. Сб. «Спектроскопия газоразрядной плазмы», под ред. С. Э. Фриша, 7. Изд. «Наука», 1970.
- [3] W. L. Miller, A. R. Gordon. J. Phys. Chem., 35, 2878, 1931.
- [4] В. В. Скидан и Е. Я. Шрейдер. Опт. и спектр., 27, 532, 1969; Опт. и спектр., 28, 627, 1970.

Поступило в Редакцию 24 сентября 1971 г.

УДК 535.34 : 548.0 : 546.21

СТРУКТУРА ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ α -КИСЛОРОДА ПРИ $T=1.3^\circ\text{K}$

I. ДАЛЕКАЯ КРАСНАЯ ОБЛАСТЬ ($13\ 000 \div 16\ 000 \text{ см}^{-1}$)

А. Ф. Прихолько и Л. И. Шанский

Кристаллический кислород благодаря наличию от нуля электронному спину его молекул обладает редкими для молекулярных кристаллов магнитными свойствами. Парамагнитный в высокотемпературной γ - и β -фазах, он антиферромагнитен в низкотемпературной α -модификации [1, 2], что придает особый интерес изучению его спектра. Поглощение света кристаллами кислорода, обязанное его электронным возбуждениям, начинается в близкой инфракрасной и примыкающей к ней далекой красной области, где расположены две слабые серии, состоящие из немногих полос. Из данных, полученных при 20.3°K , следует их соответствие сериям поглощения газообразного кислорода, отвечающим переходам из основного состояния ${}^3\Sigma_g^-$ молекулы O_2 на два низко лежащие уровня ${}^1\Delta_g$ и ${}^1\Sigma_g^+$ [3, 4]. Однако условия опытов не позволили получить достаточных сведений о тонкой структуре полос поглощения кристаллов, изучение которой представляет большой интерес.

С этой целью мы исследовали поглощение света в α -кислороде в области от $13\ 000$ до $16\ 000 \text{ см}^{-1}$, где расположены полосы, отвечающие переходу $({}^3\Sigma_g^-) \rightarrow ({}^1\Sigma_g^+)$.¹ Для работы использовался дифракционный прибор ДСФ-3 с дисперсией 2\AA/mm ; источник света — криптоновая лампа ДКСШ-1000; спектр сравнения — спектр дуги между железными электродами. Кристаллы α -кислорода, замороженного в кварцевой кювете с плоскими окошками, охлаждались до 4 и 1.3°K в специальном криостате [5]. Так как поглощение слабое, то толщины кювет были порядка $10 \div 20 \text{ mm}$.

¹ Символы состояний взяты в скобки, чтобы указать их принадлежность кристаллу.